



(19) 대한민국특허청(KR)
 (12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2016-0005284
 (43) 공개일자 2016년01월14일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H01L 27/32 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2014-0083952

(22) 출원일자 2014년07월04일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

엘지디스플레이 주식회사

서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)

(72) 발명자

이종호

서울 도봉구 도봉로180길 6-83, 4동 212호 (도봉동, 삼환도봉아파트)

타카스기 신지

경기 파주시 월롱면 엘씨디로8번길 47-9, 203호
(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인천문

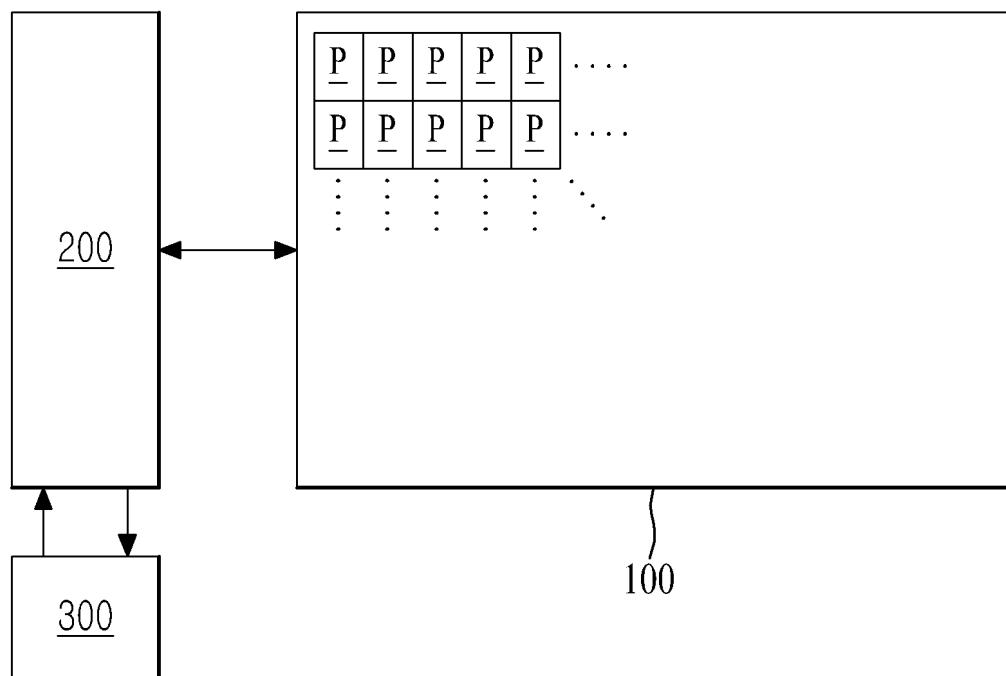
전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 발명의 명칭 유기 발광 표시 장치

(57) 요약

본 발명은 구동 트랜지스터의 센싱 시간을 단축할 수 있도록 한 유기 발광 표시 장치를 제공하는 것으로, 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치는 데이터 전압에 기초한 데이터 전류를 출력하여 유기 발광 소자를 발광시키는 구동 트랜지스터를 포함하는 복수의 화소로 이루어지는 표시 패널; 및 상기 표시 패널을 센싱 모드 또는 표시 모드(뒷면에 계속)

대표도 - 도2



드로 동작시키고, 상기 센싱 모드시 상기 각 화소의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워(source follow) 모드로 동작 시키면서 상기 유기 발광 소자와 상기 구동 트랜지스터 사이의 센싱 노드에 연결되는 레퍼런스 라인을 통해 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 센싱하고, 상기 표시 모드시 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 기반으로 화소별 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동하는 패널 구동부를 포함하며, 상기 센싱 모드시 상기 패널 구동부는 상기 구동 트랜지스터에 흐르는 전류에 따른 센싱 전압이 포화되는 전압 포화 구간 이전에 설정된 단축 센싱 시점에서 상기 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 센싱할 수 있다.

(72) 발명자

장민규

경기 파주시 탄현면 소금쟁이길 2, 303호

박효진

전남 여수시 신월2길 11, 103동 1503호 (신월동,
신월코아루아파트)

명세서

청구범위

청구항 1

데이터 전압에 기초한 데이터 전류를 출력하여 유기 발광 소자를 발광시키는 구동 트랜지스터를 포함하는 복수의 화소로 이루어지는 표시 패널; 및

상기 표시 패널을 센싱 모드 또는 표시 모드로 동작시키고, 상기 센싱 모드시 상기 각 화소의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워(source follow) 모드로 동작시키면서 상기 유기 발광 소자와 상기 구동 트랜지스터 사이의 센싱 노드에 연결되는 레퍼런스 라인을 통해 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 센싱하고, 상기 표시 모드시 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 기반으로 화소별 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동하는 패널 구동부를 포함하며,

상기 센싱 모드시 상기 패널 구동부는 상기 구동 트랜지스터에 흐르는 전류에 따른 센싱 전압이 포화되는 전압 포화 구간 이전에 설정된 단축 센싱 시점에서 상기 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 센싱하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값으로 이루어지고,

상기 표시 모드시, 상기 패널 구동부는 상기 단축 센싱 시점에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값을 기반으로, 상기 전압 포화 구간에 대응되는 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 산출하고, 산출된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 기반으로 화소별 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 센싱 모드에 의해 센싱된 화소별 구동 트랜지스터에 대한 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값, 및 문턱 전압 예측 함수에 대한 이동도 센싱 값별 계수들이 저장되어 있는 메모리부를 더 포함하고,

상기 표시 모드시, 상기 패널 구동부는 상기 메모리부에서 상기 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값에 대응되는 문턱 전압 예측 함수의 계수들을 추출하고, 추출된 화소별 계수들과 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값을 이용한 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산을 통해 상기 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 산출하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 문턱 전압 예측 함수는 상기 단축 센싱 시점에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 제 1 문턱 전압 센싱 값과 상기 전압 포화 구간에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 제 2 문턱 전압 센싱 값에 토대로, 상기 이동도 센싱 값별로 제 1 문턱 전압 센싱 값에 대한 제 2 문턱 전압 센싱 값으로 좌표화하고 선형 보간하여 산출된 이동도 센싱 값별 제 1 함수를 기반으로 설정된 1차 함수인 유기 발광 표시 장치.

청구항 5

제 4 항에 있어서,

상기 문턱 전압 예측 함수의 1차항 계수는 상기 이동도 센싱 값별 제 1 함수들의 1차항 계수들을 이동도 센싱 값에 대해 좌표화하고 선형 보간하여 산출된 제 2 함수로 이루어지고,

상기 문턱 전압 예측 함수의 0차항 계수는 상기 이동도 센싱 값별 제 1 함수들의 0차항 계수들을 이동도 센싱 값에 대해 좌표화하고 선형 보간하여 산출된 제 3 함수로 이루어지며,

상기 메모리부에 저장되어 있는 상기 문턱 전압 예측 함수의 계수들은 상기 제 2 함수의 1차항 계수와 0차항 계수, 및 상기 제 3 함수의 1차항 계수와 0차항 계수인 유기 발광 표시 장치.

청구항 6

제 5 항에 있어서,

상기 표시 모드에서 상기 패널 구동부는,

상기 메모리부에서 상기 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값에 대응되는 상기 제 2 함수의 1차항 계수와 0차항 계수, 및 상기 제 3 함수의 1차항 계수와 0차항 계수를 추출하고,

상기 추출된 제 2 함수의 1차항 계수와 0차항 계수, 상기 추출된 상기 제 3 함수의 1차항 계수와 0차항 계수 및 상기 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값을 이용한 상기 제 2 및 제 3 함수 각각의 연산을 통해 상기 문턱 전압 예측 함수의 1차항 계수와 0차항 계수를 산출하고,

상기 산출된 문턱 전압 예측 함수의 1차항 계수와 0차항 계수 및 상기 단축 센싱 시점에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값을 이용한 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산을 통해 상기 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 산출하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 7

제 2 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 표시 모드에서 상기 패널 구동부는,

상기 메모리부에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값과 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 예측 값 간의 편차에 기초하여 화소별 특성 보상값을 산출하고, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소의 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 구동 트랜지스터의 구동 특성 값은 구동 트랜지스터의 문턱 전압 값과 이동도 값으로 이루어지고,

상기 센싱 모드시, 상기 패널 구동부는 상기 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값과 센싱용 기준 데이터 전압별로 설정된 이동도 계수를 기반으로, 화소별 센싱용 데이터 전압을 생성하고, 상기 화소별 센싱용 데이터 전압에 이용하여 상기 각 화소의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워 모드로 동작시켜 상기 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압과 이동도 각각을 센싱하여 상기 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값 각각을 생성하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 9

제 8 항에 있어서,

상기 센싱 모드에 의해 센싱된 화소별 구동 트랜지스터에 대한 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값, 및 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 계수가 저장되어 있는 메모리부를 더 포함하고,

상기 센싱 모드에서 상기 패널 구동부는 상기 메모리부에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값과 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 계수를 기반으로 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값에 따른 이동도 보상 계인 값을 산출하고, 센싱용 기준 화소 데이터와 상기 이동도 보상 계인 값을 이용하여 상기 화소별 센싱용 데이터 전압을 생성하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 10

제 8 항에 있어서,

상기 센싱 모드에서 상기 패널 구동부는,

상기 메모리부에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값을 기반으로 평균 이동도 값을 산출하고,

상기 평균 이동도 값과 상기 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값을 이용하여 이동도 보상 값을 산출하고,

상기 이동도 보상 값과 상기 이동도 계수를 이용하여 이동도 보상 개인 값을 산출하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 11

제 8 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 표시 모드에서 상기 패널 구동부는,

상기 메모리부에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 센싱 값 간의 편차에 기초하여 화소별 특성 보상값을 산출하고, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소의 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동하는 유기 발광 표시 장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 유기 발광 표시 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 화소별 구동 트랜지스터의 특성 편차를 보상할 수 있는 유기 발광 표시 장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근, 평판 표시 장치는 멀티미디어의 발달과 함께 그 중요성이 증대되고 있다. 이에 부응하여 액정 표시 장치, 플라즈마 표시 장치, 유기 발광 표시 장치 등의 평판 표시 장치가 상용화되고 있다. 이러한, 평판 표시 장치 중에서 유기 발광 표시 장치는 고속의 응답속도를 가지며, 소비 전력이 낮고, 자체 발광이므로 시야각에 문제가 없어 차세대 평판 표시 장치로 주목받고 있다.

[0003] 도 1은 일반적인 유기 발광 표시 장치의 화소 구조를 설명하기 위한 회로도이다.

[0004] 도 1을 참조하면, 일반적인 유기 발광 표시 장치의 화소(P)는 스위칭 트랜지스터(Tsw), 구동 트랜지스터(Tdr), 커패시터(Cst), 및 유기 발광 소자(OLED)를 구비한다.

[0005] 상기 스위칭 트랜지스터(Tsw)는 스캔 라인(SL)에 공급되는 스캔 펄스(SP)에 따라 스위칭되어 데이터 라인(DL)에 공급되는 데이터 전압(Vdata)을 구동 트랜지스터(Tdr)에 공급한다. 상기 구동 트랜지스터(Tdr)는 스위칭 트랜지스터(Tsw)로부터 공급되는 데이터 전압(Vdata)에 따라 스위칭되어 구동 전원 라인으로부터 공급되는 구동 전원(EVdd)으로부터 유기 발광 소자(OLED)로 흐르는 데이터 전류(Ioled)를 제어한다. 상기 커패시터(Cst)는 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트 단자와 소스 단자 사이에 접속되어 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트 단자에 공급되는 데이터 전압(Vdata)에 대응되는 전압을 저장하고, 저장된 전압으로 구동 트랜지스터(Tdr)의 텐-온시킨다. 상기 유기 발광 소자(OLED)는 구동 트랜지스터(Tdr)의 소스 단자와 캐소드 라인(EVss) 사이에 전기적으로 접속되어 구동 트랜지스터(Tdr)로부터 공급되는 데이터 전류(Ioled)에 의해 발광한다. 이러한 일반적인 유기 발광 표시 장치의 각 화소(P)는 데이터 전압(Vdata)에 따른 구동 트랜지스터(Tdr)의 스위칭을 이용하여 구동 전원(EVdd)으로부터 유기 발광 소자(OLED)로 흐르는 데이터 전류(Ioled)의 크기를 제어하여 유기 발광 소자(OLED)를 발광시킴으로써 소정의 영상을 표시하게 된다.

[0006] 이와 같은, 일반적인 유기 발광 표시 장치에서는 박막 트랜지스터의 제조 공정의 불균일성에 따라 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압(Vth)/이동도(Mobility) 특성이 유기 발광 표시 패널의 위치에 따라 다르게 나타나는 문제점이 있다. 이에 따라, 일반적인 유기 발광 표시 장치에서는 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)에 동일한 데이터 전압(Vdata)을 인가하더라도 유기 발광 소자(OLED)에 흐르는 전류의 편차로 인해 균일한 화질을 구현할 수 없다는 문제점이 있다.

[0007] 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 대한민국 공개특허공보 제10-2012-0076215호(이하, "선행기술문헌"이라 함)의 유기전계발광표시장치는 각 화소에 센서 트랜지스터를 추가하고, 스위칭 트랜지스터와 센서 트랜지스터의 스위칭을 이용해 센서 트랜지스터에 연결된 레퍼런스 라인을 통해 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 센싱하여 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상하는 외부 보상 기술이 개시되어 있다.

[0008] 상기 선행기술문현의 유기 발광 표시 장치는 각 화소의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워(source follower) 모드로 동작시켜 센싱하는 방식으로 아날로그-디지털 변환기에 의해 센싱된 값을 기반으로 구동 트랜지스터의 문턱 전압 변화를 파악하여 보상하게 된다.

[0009] 그러나, 선행기술문현에 개시된 센싱 방법에서, 센싱 전압은 커패시턴스의 영향으로 인해 충분한 시간이 경과해야 포화(saturation)되고, 이로 인해 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 정확히 보상하기 위해서는 구동 트랜지스터가 턴-오프될 때까지 기다려야 하기 때문에 센싱 시간이 길어져 센싱 속도가 느리다는 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 본 발명은 전술한 문제점을 해결하고자 안출된 것으로, 구동 트랜지스터의 센싱 시간을 단축할 수 있도록 한 유기 발광 표시 장치를 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.

[0011] 또한, 본 발명은 센싱 시간의 단축시 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차에 따른 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 편차를 보상할 수 있도록 한 유기 발광 표시 장치를 제공하는 것을 다른 기술적 과제로 한다.

[0012] 위에서 언급된 본 발명의 기술적 과제 외에도, 본 발명의 다른 특징 및 이점들이 이하에서 기술되거나, 그러한 기술 및 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0013] 전술한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치는 데이터 전압에 기초한 데이터 전류를 출력하여 유기 발광 소자를 발광시키는 구동 트랜지스터를 포함하는 복수의 화소로 이루어지는 표시 패널; 및 상기 표시 패널을 센싱 모드 또는 표시 모드로 동작시키고, 상기 센싱 모드시 상기 각 화소의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워(source follow) 모드로 동작시키면서 상기 유기 발광 소자와 상기 구동 트랜지스터 사이의 센싱 노드에 연결되는 레퍼런스 라인을 통해 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 센싱하고, 상기 표시 모드시 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 기반으로 화소별 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동하는 패널 구동부를 포함하며, 상기 센싱 모드시 상기 패널 구동부는 상기 구동 트랜지스터에 흐르는 전류에 따른 센싱 전압이 포화되는 전압 포화 구간 이전에 설정된 단축 센싱 시점에서 상기 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 센싱할 수 있다.

[0014] 상기 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값으로 이루어지고, 상기 표시 모드시, 상기 패널 구동부는 상기 단축 센싱 시점에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값을 기반으로, 상기 전압 포화 구간에 대응되는 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 산출하고, 산출된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 기반으로 화소별 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동할 수 있다.

[0015] 상기 유기 발광 표시 장치는 상기 센싱 모드에 의해 센싱된 화소별 구동 트랜지스터에 대한 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값, 및 문턱 전압 예측 함수에 대한 이동도 센싱 값별 계수들이 저장되어 있는 메모리부를 더 포함하고, 상기 표시 모드시, 상기 패널 구동부는 상기 메모리부에서 상기 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값에 대응되는 문턱 전압 예측 함수의 계수들을 추출하고, 추출된 화소별 계수들과 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값을 이용한 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산을 통해 상기 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 산출할 수 있다.

[0016] 상기 문턱 전압 예측 함수는 상기 단축 센싱 시점에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 제 1 문턱 전압 센싱 값과 상기 전압 포화 구간에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 제 2 문턱 전압 센싱 값에 토대로, 상기 이동도 센싱 값별로 제 1 문턱 전압 센싱 값에 대한 제 2 문턱 전압 센싱 값으로 좌표화하고 선형 보간하여 산출된 이동도 센싱 값별 제 1 함수를 기반으로 설정된 1차 함수일 수 있다.

[0017] 상기 문턱 전압 예측 함수의 1차항 계수는 상기 이동도 센싱 값별 제 1 함수들의 1차항 계수들을 이동도 센싱 값에 대해 좌표화하고 선형 보간하여 산출된 제 2 함수로 이루어지고, 상기 문턱 전압 예측 함수의 0차항 계수는 상기 이동도 센싱 값별 제 1 함수들의 0차항 계수들을 이동도 센싱 값에 대해 좌표화하고 선형 보간하여 산출된 제 3 함수로 이루어지며, 상기 메모리부에 저장되어 있는 상기 문턱 전압 예측 함수의 계수들은 상기 제 2

함수의 1차항 계수와 0차항 계수, 및 상기 제 3 함수의 1차항 계수와 0차항 계수일 수 있다.

[0018] 상기 표시 모드에서 상기 패널 구동부는 상기 메모리부에서 상기 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값에 대응되는 상기 제 2 함수의 1차항 계수와 0차항 계수, 및 상기 제 3 함수의 1차항 계수와 0차항 계수를 추출하고; 상기 추출된 제 2 함수의 1차항 계수와 0차항 계수, 상기 추출된 상기 제 3 함수의 1차항 계수와 0차항 계수 및 상기 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값을 이용한 상기 제 2 및 제 3 함수 각각의 연산을 통해 상기 문턱 전압 예측 함수의 1차항 계수와 0차항 계수를 산출하고; 상기 산출된 문턱 전압 예측 함수의 1차항 계수와 0차항 계수 및 상기 단축 센싱 시점에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값을 이용한 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산을 통해 상기 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 산출할 수 있다.

[0019] 상기 표시 모드에서 상기 패널 구동부는 상기 메모리부에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값과 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 예측 값 간의 편차에 기초하여 화소별 특성 보상값을 산출하고, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소의 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동할 수 있다.

[0020] 상기 구동 트랜지스터의 구동 특성 값은 구동 트랜지스터의 문턱 전압 값과 이동도 값으로 이루어지고, 상기 센싱 모드시, 상기 패널 구동부는 상기 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값과 센싱용 기준 데이터 전압별로 설정된 이동도 계수를 기반으로, 화소별 센싱용 데이터 전압을 생성하고, 상기 화소별 센싱용 데이터 전압에 이용하여 상기 각 화소의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워 모드로 동작시켜 상기 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압과 이동도 각각을 센싱하여 상기 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값 각각을 생성할 수 있다.

[0021] 상기 유기 발광 표시 장치는 상기 센싱 모드에 의해 센싱된 화소별 구동 트랜지스터에 대한 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값, 및 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 계수가 저장되어 있는 메모리부를 더 포함하고, 상기 센싱 모드에서 상기 패널 구동부는 상기 메모리부에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값과 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 계수를 기반으로 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값에 따른 이동도 보상 계인 값을 산출하고, 센싱용 기준 화소 데이터와 상기 이동도 보상 계인 값을 이용하여 상기 화소별 센싱 용 데이터 전압을 생성할 수 있다.

[0022] 상기 센싱 모드에서 상기 패널 구동부는 상기 메모리부에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값을 기반으로 평균 이동도 값을 산출하고, 상기 평균 이동도 값과 상기 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값을 이용하여 이동도 보상 값을 산출하고, 상기 이동도 보상 값과 상기 이동도 계수를 이용하여 이동도 보상 계인 값을 산출할 수 있다.

[0023] 상기 표시 모드에서 상기 패널 구동부는 상기 메모리부에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 센싱 값 간의 편차에 기초하여 화소별 특성 보상값을 산출하고, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소의 입력 데이터를 보정하여 각 화소를 구동할 수 있다.

발명의 효과

[0024] 상기 과제의 해결 수단에 의하면, 본 발명은 센싱 전압의 전압 포화 구간 이전에 설정된 단축 센싱 시점에서 문턱 전압을 센싱함으로써 화소별 구동 트랜지스터의 센싱 시간을 단축시킬 수 있다.

[0025] 또한, 본 발명은 단축 센싱 시점에서 센싱된 문턱 전압으로부터 전압 포화 구간의 문턱 전압을 예측하여 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상함으로써 센싱 시간의 단축으로 인한 발생되는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차를 보상하고, 이를 통해 표시 패널의 휘도 균일도를 개선할 수 있다.

[0026] 또한, 본 발명은 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값에 기초한 화소별 센싱용 데이터 전압을 생성하여 단축 센싱 시점에서 문턱 전압을 센싱함으로써 화소별 구동 트랜지스터의 센싱 시간을 단축시키면서 센싱 시간의 단축으로 인한 발생되는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차를 보상하고, 이를 통해 표시 패널의 휘도 균일도를 개선할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0027] 도 1은 일반적인 유기 발광 표시 장치의 화소 구조를 설명하기 위한 회로도이다.

도 2는 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다.

도 3은 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치의 센싱 모드에 있어서, 센싱 전압 파형과 단축 센싱 시

점을 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치의 센싱 모드에 있어서, 센싱 전압 파형과 단축 센싱 시 점을 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치의 구성을 설명하기 위한 도면이다.

도 6는 도 5에 도시된 화소 구조를 설명하기 위한 회로도이다.

도 7은 도 5에 도시된 컬럼(column) 구동부를 설명하기 위한 블록도이다.

도 8은 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치에 있어서, 센싱 모드시 구동 파형도이다.

도 9는 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치에 있어서, 표시 모드시 구동 파형도이다.

도 10은 본 발명과 비교 예 1 및 2에 대한 표시 패널의 휘도 균일도를 설명하기 위한 그래프이다.

도 11은 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치의 구성을 설명하기 위한 도면이다.

도 12는 본 발명과 비교 예에 있어서, 데이터 전압에 대한 구동 트랜지스터에 흐르는 전류를 나타내는 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0028] 본 명세서에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할 것이다.

[0029] 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 정의하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하고, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위한 것으로, 이를 용어들에 의해 권리범위가 한정되어서는 아니 된다. "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. "적어도 하나"의 용어는 하나 이상의 관련 항목으로부터 제시 가능한 모든 조합을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, "제 1 항목, 제 2 항목 및 제 3 항목 중에서 적어도 하나"의 의미는 제 1 항목, 제 2 항목 또는 제 3 항목 각각 뿐만 아니라 제 1 항목, 제 2 항목 및 제 3 항목 중에서 2개 이상으로부터 제시될 수 있는 모든 항목의 조합을 의미한다.

[0030] 이하에서는 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다.

[0031] 도 2는 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다.

[0032] 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광 표시 장치는 표시 패널(100), 패널 구동부(200), 및 메모리부(300)를 포함한다.

[0033] 상기 표시 패널(100)은 데이터 전압에 기초한 데이터 전류를 출력하여 유기 발광 소자를 발광시키는 구동 트랜지스터를 포함하는 복수의 화소(P)로 이루어질 수 있다.

[0034] 상기 패널 구동부(200)는 표시 패널(100)을 표시 모드 또는 센싱 모드로 구동한다. 여기서, 상기 표시 모드란 입력 데이터에 따라 각 화소(P)에 포함된 유기 발광 소자를 발광시켜 소정의 영상을 표시하기 위한 표시 패널(100)의 구동을 의미하며, 상기 센싱 모드란 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 및/또는 이동도를 센싱하기 위한 표시 패널(100)의 구동을 의미한다. 예를 들어, 상기 센싱 모드는 유기 발광 표시 장치의 제품 출하 전 사용자(또는 제품) 설정시 수행될 수 있고, 유기 발광 표시 장치의 제품 출하 이후 사용자의 설정 또는 설정된 주기마다 수행될 수 있다. 여기서, 상기 설정된 주기는 유기 발광 표시 장치의 전원 온 구간, 유기 발광 표시 장치의 전원 오프 구간, 설정된 구동 시간 이후 전원 온 구간, 또는 설정된 구동 시간 이후 전원 오프 구간일 수 있다.

[0035] 상기 센싱 모드시, 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)는 상기 각 화소의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워(source follower) 모드로 동작시키면서 유기 발광 소자와 구동 트랜지스터 사이의 센싱 노드에 연결되는 레퍼런스 라인을 통해 센싱 노드의 전압을 센싱하되, 센싱 노드의 전압이 포화되는 전압 포화 구간 이전으로 설정된 단축 센

상 시점(또는 센싱 노드의 전압이 상승하는 임의의 시점)에서 센싱 노드의 전압을 센싱하여 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 생성하고, 상기 표시 모드시 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값을 기반으로 화소별 입력 데이터를 보정하여 각 화소(P)를 구동한다.

[0036] 예를 들어, 상기 센싱 모드시, 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 구동 트랜지스터의 소스 전극인 센싱 노드를 일정한 전압 레벨을 갖는 프리차징 전압(Vpre)으로 초기화한 다음, 센싱용 데이터 전압(Vdata_sen)을 구동 트랜지스터의 게이트 전극에 공급하면서, 소스 팔로워 모드로 동작하는 구동 트랜지스터에 흐르는 전류에 따른 센싱 전압이 포화되는 포화 시점(Tsat) 이전으로 설정된 단축 센싱 시점(Tsen)에 센싱 노드의 전압을 센싱한다. 즉, 상기 센싱 전압은 커페시턴스의 영향으로 초기화 이후에 충분한 시간이 경과한 후에 포화되기 때문에 구동 트랜지스터가 턴-오프될 때까지 기다려야 하므로 센싱 시간이 길어지게 되지만, 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)는 상기 센싱 노드의 센싱 전압이 포화되는 전압 포화 구간(Tsat) 이전으로 설정된 단축 센싱 시점(Tsen)에서 센싱 전압을 센싱함으로써 센싱 모드의 센싱 시간을 단축한다.

[0037] 상기 표시 모드시, 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)는 단축 센싱 시점(Tsen)에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값, 즉 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값을 기반으로 전압 포화 구간(Tsat)의 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 산출하고, 산출된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값에 따라 화소별 입력 데이터를 보정하여 각 화소(P)를 구동한다.

[0038] 예를 들어, 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)는 메모리부(300)에서 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값에 대응되는 문턱 전압 예측 함수의 계수들을 추출하고, 추출된 화소별 계수들과 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값을 이용한 문턱 전압 예측 함수의 연산을 통해 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값을 산출할 수 있다.

[0039] 상기 메모리부(300)에는 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)에서 문턱 전압 예측 함수의 연산을 위한 계수들이 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값별로 저장되어 있다. 상기 문턱 전압 예측 함수는, 아래의 수학식 1과 같이, 1 차 함수로 이루어질 수 있다.

수학식 1

$$V_{th'}_{sat} = M \times V_{th_sen} + N$$

$$M = A \times \alpha_{sen} + B$$

$$N = C \times \alpha_{sen} + D$$

[0040]

[0041] 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산($V_{th'}_{sat}$)을 위한 계수들(A, B, C, D)은 다음과 같은 과정을 통해 산출되어 상기 메모리부(300)에 저장될 수 있는데, 이를 상기 수학식 1을 결부하여 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

[0042] 우선, 전술한 센싱 모드를 통해, 화소별 구동 트랜지스터의 이동도를 센싱하여, 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값을 산출한다. 추가적으로, 상기 화소별 이동도 센싱 값을 기반으로 표시 패널(100)에 대한 이동도 맵을 생성할 수 있다.

[0043] 그런 다음, 전술한 센싱 모드를 통해, 상기 단축 센싱 시점(Tsen)에서 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 센싱하여, 화소별 구동 트랜지스터의 제 1 문턱 전압 센싱 값을 산출한다. 추가적으로, 상기 화소별 제 1 문턱 전압 센싱 값을 기반으로 표시 패널(100)에 대한 제 1 문턱 전압 맵을 생성할 수 있다.

[0044] 그런 다음, 전술한 센싱 모드를 통해, 상기 전압 포화 구간(Tsat)에서 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 센싱하여, 화소별 구동 트랜지스터의 제 2 문턱 전압 센싱 값을 산출한다. 추가적으로, 상기 화소별 제 2 문턱 전압 센싱 값을 기반으로 표시 패널(100)에 대한 제 2 문턱 전압 맵을 생성할 수 있다.

[0045] 그런 다음, 산출된 화소별 이동도 센싱 값을 이용하여 표시 패널(100) 내에서 동일한 이동도 센싱 값을 갖는 화소(P)들을 추출한다.

[0046] 그런 다음, 이동도 센싱 값별로 추출된 화소(P)들의 제 1 문턱 전압 센싱 값들과 제 2 문턱 전압 센싱 값들을

상기 제 1 문턱 전압 센싱 값에 대한 제 2 문턱 전압 센싱 값으로 좌표화(plot)하고 선형 보간(linear interpolation)하여 이동도 센싱 값별 제 1 함수를 산출한다.

[0047] 그런 다음, 이동도 센싱 값별 제 1 함수에서 1차항 계수를 추출하고, 추출된 이동도 센싱 값별 1차항 계수들을 이동도 센싱 값(a_sen)에 대해 좌표화하고 선형 보간하여 제 2 함수(M)를 산출한다.

[0048] 그런 다음, 이동도 센싱 값별 제 1 함수 각각에서 0차항 계수(또는 상수)를 추출하고, 추출된 이동도 센싱 값별 0차항 계수들을 이동도 센싱 값(a_sen)에 대해 좌표화하고 선형 보간하여 제 3 함수(N)를 산출한다.

[0049] 그런 다음, 상기 제 2 함수(M)에서 1차항 계수(A)와 0차항 계수(B), 및 상기 제 3 함수(N)에서 1차항 계수(C)와 0차항 계수(D) 각각을 추출하여 메모리부(300)에 저장한다.

[0050] 이와 같은, 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산(Vth'_sat)을 위한 계수들(A, B, C, D)은 이동도 센싱 값 별로 단축 센싱 시점(Tsen)에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 제 1 문턱 전압 센싱 값과 전압 포화 구간(Tsat)에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 제 2 문턱 전압 센싱 값을 기반으로 산출됨으로써 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값(a_sen)과 단축 센싱 시점(Tsen)의 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen) 및 상기 계수들(A, B, C, D)을 이용한 상기 문턱 전압 예측 함수(Vth'_sat)의 연산을 통해 단축 센싱 시점(Tsen)의 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)으로부터 보다 정확한 전압 포화 구간(Tsat)의 문턱 전압 예측 값(Vth'_sat)을 산출하게 된다.

[0051] 상기 표시 모드시, 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)는 상기 수학식 1의 연산을 통해 산출된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 예측 값과 최초의 센싱 모드에 의해 센싱되어 메모리부(300)에 저장된 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 예측 값 간의 편차에 기초하여 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 변화를 보상하기 위한 화소별 특성 보상값을 산출한 다음, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소(P)의 입력 데이터를 보정하여 화소별 보정 데이터를 생성해 각 화소(P)를 구동한다.

[0052] 이와 같은, 제 1 예에 따른 패널 구동부(200)는 단축 센싱 시점(Tsen)에서 센싱된 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)과 이동도 센싱 값(a_sen)으로부터 전압 포화 구간(Tsat)의 문턱 전압을 예측함으로써 화소별 구동 트랜지스터의 센싱 시간을 단축하면서 센싱 시간의 단축으로 인한 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차에 따른 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 편차를 보상한다.

[0053] 제 2 예에 따른 패널 구동부(200)는 센싱 모드시, 메모리부(300)에 저장되어 있는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값과 센싱용 기준 데이터 전압에 대응되는 이동도 계수를 기반으로 화소별 이동도 보상 계인 값을 산출해 화소별 센싱용 데이터 전압을 생성하고, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 화소별 센싱용 데이터 전압(Vdata'_sen)을 이용하여 각 화소의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워 모드로 동작시키면서 상기 단축 센싱 시점(Tsen)에서 상기 레퍼런스 라인을 통해 센싱 노드의 전압을 센싱하여 화소별 구동 트랜지스터의 구동 특성 값, 즉 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값을 생성해 메모리부(300)에 저장한다. 즉, 센싱 모드시, 상기 패널 구동부(200)는, 하기의 수학식 2의 연산을 통해 상기 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)를 생성하고, 생성된 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)에 대응되는 화소별 센싱용 데이터 전압(Vdata'_sen)을 이용하여 각 화소(P)를 센싱 모드로 구동시킬 수 있다.

수학식 2

$$DATA = \alpha_{gain} \times DATA_ref$$

$$\alpha_{gain} = [(\alpha_{comp} - 1) \times \alpha_{coe}] + 1$$

$$\alpha_{comp} = \left(\frac{\alpha_{avg}}{\alpha_{sen}} \right)^{1/2}$$

[0054]

[0055] 이하, 제 2 예에 따른 패널 구동부(200)가 상기 수학식 2의 연산을 통해 상기 화소별 센싱용 화소 데이터(DAT

A)를 생성하는 과정을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

[0056] 우선, 상기 메모리부(300)에는 이전의 센싱 모드에 의해 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 이동도 센싱 값(a_{sen}), 및 사전 실험에 의해 설정된 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 계수(a_{coe})가 저장되어 있다.

[0057] 상기 제 2 예에 따른 패널 구동부(200)는 상기 메모리부(300)에서 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값(a_{sen})과 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 계수(a_{coe})를 추출한다.

[0058] 그런 다음, 상기 제 2 예에 따른 패널 구동부(200)는 추출된 화소별 이동도 센싱 값(a_{sen})에 기초하여 표시 패널(100)의 모든 화소(P)의 이동도 센싱 값(a_{sen})에 대한 평균 이동도 값(a_{avg})을 산출하고, 평균 이동도 값(a_{avg})을 화소별 이동도 센싱 값(a_{sen})으로 제산 연산하고, 그 결과 값을 1/2 제곱 연산하여 이동도 보상 값(a_{comp})을 산출한다.

[0059] 그런 다음, 상기 제 2 예에 따른 패널 구동부(200)는 이동도 보상 값(a_{comp})에서 1을 감산하고, 그 결과 값에 상기 이동도 계수(a_{coe})을 승산 연산하고, 그 결과 값에 1을 가산하여 이동도 보상 계인 값(a_{gain})을 화소별로 산출한다.

[0060] 그런 다음, 상기 제 2 예에 따른 패널 구동부(200)는 화소별 이동도 보상 계인 값(a_{gain})과 설정된 센싱용 기준 데이터 전압에 대응되는 센싱용 기준 화소 데이터(DATA_ref)를 승산 연산하여 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA_A)를 생성하고, 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)에 대응되는 화소별 센싱용 데이터 전압(Vdata'_sen)을 생성한다.

[0061] 한편, 상기 메모리부(300)에 저장되는 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 계수(a_{coe})를 산출하는 과정은 다음과 같다.

[0062] 우선, 0과 1 사이의 이동도 계수(a_{coe})를 이용하여 상기 수학식 2의 연산에 따른 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)에 대응되는 화소별 센싱용 데이터 전압을 생성하고, 화소별 센싱용 데이터 전압을 이용한 센싱 모드를 수행함으로써 센싱용 기준 데이터 전압별로 이동도 센싱 값(a_{sen})에 대한 센싱 전압의 기울기를 산출한다.

[0063] 그리고, 상기 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 센싱 값(a_{sen})에 대한 센싱 전압의 기울기에서 이동도 센싱 값(a_{sen})이 0(zero)에 해당되는 이동도 계수(a_{coe})를 추출하여 메모리부(300)에 저장한다.

[0064] 따라서, 메모리부(300)에는 센싱용 기준 데이터 전압별로 각 화소의 이동도 계수(a_{coe})가 개별적으로 저장되게 된다. 이와 같은, 화소별 이동도 계수(a_{coe})는 센싱 시간 단축으로 인한 상기 센싱 모드의 단축 센싱 시점(Tsen)에서 발생되는 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 이동도 편차(a_{high} , a_{low})를 보상하기 위한 화소별 센싱용 데이터 전압(Vdata'_sen)을 생성하는데 사용된다.

[0065] 상기 표시 모드시, 제 2 예에 따른 패널 구동부(200)는 메모리부(300)에 저장된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 센싱 값 간의 편차에 기초하여 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 변화를 보상하기 위한 화소별 특성 보상값을 산출한 다음, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소(P)의 입력 데이터를 보정하여 화소별 보정 데이터를 생성해 각 화소(P)를 구동한다.

[0066] 이와 같은, 제 2 예에 따른 패널 구동부(200)는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값(a_{sen})에 기초한 화소별 센싱용 데이터 전압(Vdata'_sen)을 이용하여 전압 포화 구간(Tsat) 이전에 설정된 단축 센싱 시점(Tsen)에서 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압과 이동도를 센싱함으로써 화소별 구동 트랜지스터의 센싱 시간을 단축하면서 센싱 시간의 단축으로 인한 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차에 따른 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 편차를 보상한다.

[0067] 이하, 도 5 내지 도 9를 참조하여 전술한 본 발명의 제 1 예에 따른 패널 구동부를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 구성을 예를 들어 설명하기로 한다.

[0068] 도 5는 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치의 구성을 설명하기 위한 도면이고, 도 6는 도 5에 도시

된 화소 구조를 설명하기 위한 회로도이다.

[0069] 도 5 및 도 6을 참조하면, 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치는 전술한 바와 같이, 표시 패널(100), 패널 구동부(200), 및 메모리부(300)를 포함한다.

[0070] 상기 표시 패널(100)은 제 1 내지 제 m (단, m 은 자연수) 스캔 제어 라인(SL $_m$ 내지 SL $_1$), 제 1 내지 제 m 센싱 제어 라인(SSL $_m$ 내지 SSL $_1$), 제 1 내지 제 n (단, n 은 m 보다 큰 자연수) 데이터 라인(DL $_n$ 내지 DL $_1$), 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL $_n$ 내지 RL $_1$), 제 1 내지 제 n 구동 전원 라인(PL $_n$ 내지 PL $_1$), 캐소드 전극(미도시), 및 복수의 화소(P)를 포함한다.

[0071] 상기 제 1 내지 제 m 스캔 제어 라인(SL $_1$ 내지 SL $_m$) 각각은 상기 표시 패널(100)의 제 1 방향, 즉 가로 방향을 따라 일정한 간격으로 나란하게 형성된다.

[0072] 상기 제 1 내지 제 m 센싱 제어 라인(SSL $_1$ 내지 SSL $_m$) 각각은 상기 스캔 제어 라인들(SL $_1$ 내지 SL $_m$) 각각과 나란하게 일정한 간격으로 형성된다.

[0073] 상기 제 1 내지 제 n 데이터 라인(DL $_1$ 내지 DL $_n$)은 상기 스캔 제어 라인들(SL $_1$ 내지 SL $_m$) 및 센싱 제어 라인들(SSL $_1$ 내지 SSL $_m$) 각각과 교차하도록 상기 표시 패널(100)의 제 2 방향, 즉 세로 방향을 따라 일정한 간격으로 나란하게 형성된다.

[0074] 상기 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL $_1$ 내지 RL $_n$) 각각은 상기 데이터 라인들(DL $_1$ 내지 DL $_n$) 각각과 나란하게 일정한 간격으로 형성된다.

[0075] 상기 제 1 내지 제 n 구동 전원 라인(PL $_1$ 내지 PL $_n$) 각각은 상기 데이터 라인들(DL $_1$ 내지 DL $_n$) 각각과 나란하게 일정한 간격으로 형성된다. 이러한 상기 제 1 내지 제 n 구동 전원 라인(PL $_1$ 내지 PL $_n$) 각각은 상기 표시 패널(100)의 상측 및/또는 하측 비표시 영역에 형성된 구동 전원 공통 라인(CPL)에 공통적으로 연결될 수 있다. 선택적으로, 상기 제 1 내지 제 n 구동 전원 라인(PL $_1$ 내지 PL $_n$) 각각은 상기 스캔 제어 라인들(SL $_1$ 내지 SL $_m$) 각각과 나란하게 일정한 간격으로 형성될 수도 있으며, 이 경우, 상기 구동 전원 공통 라인(CPL)은 상기 표시 패널(100)의 좌측 및/또는 우측 비표시 영역에 형성될 수 있다.

[0076] 상기 캐소드 전극은 상기 표시 패널(100)의 전면(全面)에 통자로 형성되거나 상기 데이터 라인들(DL $_1$ 내지 DL $_n$) 또는 상기 스캔 제어 라인들(SL $_1$ 내지 SL $_m$) 각각과 나란하게 라인 형태로 형성될 수도 있다.

[0077] 상기 복수의 서브 화소(P) 각각은 서로 교차하는 상기 제 1 내지 제 m 스캔 제어 라인(SL $_1$ 내지 SL $_m$) 각각과 상기 제 1 내지 제 n 데이터 라인(DL $_1$ 내지 DL $_n$) 각각에 의해 정의되는 화소 영역마다 형성된다. 여기서, 복수의 서브 화소(P) 각각은 적색 서브 화소, 녹색 서브 화소, 청색 서브 화소, 및 백색 서브 화소 중 어느 하나일 수 있다. 하나의 영상을 표시하는 하나의 단위 화소는 인접한 적색 서브 화소, 녹색 서브 화소, 청색 서브 화소, 및 백색 서브 화소를 포함하거나, 적색 화소, 녹색 화소, 및 청색 화소를 포함할 수 있다.

[0078] 상기 복수의 화소(P) 각각은 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1), 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw2), 구동 트랜지스터(Tdr), 커패시터(Cst), 및 유기 발광 소자(OLED)를 포함할 수 있다. 여기서, 트랜지스터(Tsw1, Tsw2, Tdr)는 박막 트랜지스터(TFT)로서 a-Si TFT, poly-Si TFT, Oxide TFT, 또는 Organic TFT 등이 될 수 있다.

[0079] 상기 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)는 제 1 스캔 펄스(SP1)에 의해 스위칭되어 데이터 라인(DL)에 공급되는 데이터 전압(Vdata)을 출력한다. 이를 위해, 상기 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)는 인접한 스캔 제어 라인(SCL)에 연결된 게이트 전극, 인접한 데이터 라인(DL)에 연결된 제 1 전극, 및 상기 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트 전극인 제 1 노드(n1)에 연결된 제 2 전극을 포함한다. 여기서, 상기 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)의 제 1 및 제 2 전극은 전류의 방향에 따라 소스 전극 또는 드레인 전극이 될 수 있다.

[0080] 상기 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw2)는 제 2 스캔 펄스(SP2)에 의해 스위칭되어 레퍼런스 라인(RL)에 공급되는 전압(Vref or Vpre)을 구동 트랜지스터(Tdr)의 소스 전극인 제 2 노드(n2)(또는 센싱 노드)에 공급한다. 이를 위해, 상기 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw2)는 인접한 센싱 제어 라인(SSL)에 연결된 게이트 전극, 인접한 레퍼런스 라인(RL)에 연결된 제 1 전극, 및 제 2 노드(n2)에 연결된 제 2 전극을 포함한다. 여기서, 상기 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw2)의 제 1 및 제 2 전극은 전류의 방향에 따라 소스 전극 또는 드레인 전극이 될 수 있다.

[0081] 상기 커패시터(Cst)는 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트 전극과 소스 전극 사이, 즉 제 1 및 제 2 노드(n1, n2) 사이에 접속되는 제 1 및 제 2 전극을 포함한다. 상기 커패시터(Cst)의 제 1 전극은 상기 제 1 노드(n1)에 연결되고, 상기 커패시터(Cst)의 제 2 전극은 상기 제 2 노드(n2)에 연결된다. 이러한 상기 커패시터(Cst)는 상

기 제 1 및 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw1, Tsw2) 각각의 스위칭에 따라 제 1 및 제 2 노드(n1, n2) 각각에 공급되는 전압의 차 전압을 충전한 후, 충전된 전압에 따라 구동 트랜지스터(Tdr)를 스위칭시킨다.

[0082] 상기 구동 트랜지스터(Tdr)는 상기 커페시터(Cst)의 전압에 의해 턴-온됨으로써 구동 전압 라인(PL)으로부터 유기 발광 소자(OLED)로 흐르는 전류 양을 제어한다. 이를 위해, 상기 구동 트랜지스터(Tdr)는 상기 제 1 노드(n1)에 연결된 게이트 전극, 상기 제 2 노드(n2)에 연결된 소스 전극, 및 구동 전압 라인(PL)에 연결된 드레인 전극을 포함한다.

[0083] 상기 유기 발광 소자(OLED)는 구동 트랜지스터(Tdr)로부터 공급되는 데이터 전류(Ioled)에 의해 발광하여 데이터 전류(Ioled)에 대응되는 휘도를 갖는 단색 광을 방출한다. 이를 위해, 상기 유기 발광 소자(OLED)는 상기 제 2 노드(n2)에 연결된 제 1 전극(예를 들어, 애노드 전극), 제 1 전극 상에 형성된 유기층(미도시), 및 유기층에 연결된 제 2 전극(예를 들어, 캐소드 전극)을 포함한다. 이때, 유기층은 정공 수송층/유기 발광층/전자 수송층의 구조 또는 정공 주입층/정공 수송층/유기 발광층/전자 수송층/전자 주입층의 구조를 가지도록 형성될 수 있다. 나아가, 상기 유기층은 유기 발광층의 발광 효율 및/또는 수명 등을 향상시키기 위한 기능층을 더 포함하여 이루어질 수 있다. 그리고, 상기 제 2 전극은 복수의 화소(P) 각각에 개별적으로 연결되거나, 복수의 화소(P)에 공통적으로 연결될 수 있으며, 이러한 상기 제 2 전극에는 저전위 전원(EVss)이 공급된다.

[0084] 상기 패널 구동부(200)는 표시 패널(100)을 센싱 모드 또는 표시 모드로 구동한다. 상기 센싱 모드시, 상기 패널 구동부(200)는 상기 각 화소(P)의 구동 트랜지스터(Tdr)를 소스 팔로워 모드로 동작시키면서 상기 단축 센싱 시점에서 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw2)를 통해 센싱 노드(n2)에 연결되는 레퍼런스 라인(RL)을 통해 센싱 노드(n2)의 전압을 센싱하여 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)과 이동도 센싱 값(a_sen) 각각을 생성해 메모리부(300)에 저장한다. 그리고, 상기 표시 모드시, 상기 패널 구동부(200)는 메모리부(300)에 저장되어 있는 화소별 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)과 이동도 센싱 값(a_sen)과 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산(Vth'_sat)을 위한 계수들(A, B, C, D)을 이용한 상기 수학식 1의 연산을 통해 상기 전압 포화 구간의 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 예측 값을 산출하고, 산출된 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 예측 값에 따라 화소별 입력 데이터(Idata)를 보정하여 각 화소(P)의 유기 발광 소자(OLED)를 발광시킨다. 이를 위해, 상기 패널 구동부(200)는 타이밍 제어부(210), 로우(row) 구동부(220), 및 컬럼(column) 구동부(230)를 포함하여 구성된다.

[0085] 상기 타이밍 제어부(210)는 사용자의 설정 또는 설정된 주기마다 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압과 이동도를 센싱하기 위한, 센싱 모드에 따라 상기 로우(row) 구동부(220)와 상기 컬럼(column) 구동부(230)를 센싱 모드로 동작시킨다. 예를 들어, 센싱 모드시, 상기 타이밍 제어부(210)는 상기 각 화소(P)의 구동 트랜지스터(Tdr)를 소스 팔로워 모드로 동작시키기 위한 제 1 및 제 2 로우 제어 신호(RCS1, RCS2)와 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA) 및 데이터 제어 신호(DCS)를 생성할 수 있다. 그리고, 센싱 모드시, 상기 타이밍 제어부(210)는 화소별 센싱용 바이어스 전압(Vdata_Sen)과 상기 컬럼(column) 구동부(230)로부터 제공되는 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 값(V_t)과 이동도 값(V_a)에 기초하여 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)과 이동도 센싱 값(a_sen)을 생성해 메모리부(300)에 저장한다.

[0086] 상기 타이밍 제어부(210)는 상기 표시 패널(110)에 영상을 표시하기 위한 표시 모드에 따라 상기 로우(row) 구동부(220)와 상기 컬럼(column) 구동부(230)를 표시 모드로 동작시킨다. 예를 들어, 상기 타이밍 제어부(210)는 상기 메모리부(300)에서 화소별 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)과 이동도 센싱 값(a_sen)과 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산(Vth'_sat)을 위한 계수들(A, B, C, D)을 추출하고, 상기 수학식 1의 연산을 통해, 상기 전압 포화 구간의 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 예측 값을 산출하고, 산출된 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 예측 값에 따라 화소별 입력 데이터(Idata)를 보정하여 화소별 보정 데이터(DATA)를 생성해 상기 컬럼(column) 구동부(230)에 제공한다. 그리고, 상기 타이밍 제어부(210)는 표시 모드에 따라 상기 각 화소(P)의 유기 발광 소자(OLED)를 발광시키기 위한 제 1 및 제 2 로우 제어 신호(RCS1, RCS2)와 데이터 제어 신호(DCS)를 생성해 상기 로우(row) 구동부(220)와 상기 컬럼(column) 구동부(230)의 구동을 제어한다.

[0087] 상기 로우(row) 구동부(220)는 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 제 1 로우 제어 신호(RCS1)에 기초하여 제 1 스캔 펄스(SP1)를 순차적으로 생성하여 상기 제 1 내지 제 m 스캔 제어 라인(SL1 내지 SLm)에 순차적으로 공급한다. 또한, 상기 로우(row) 구동부(220)는 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 제 2 로우 제어 신호(RCS2)에 기초하여 제 2 스캔 펄스(SP2)를 순차적으로 생성하여 상기 제 1 내지 제 m 센싱 제어 라인(SSL1 내지 SSLm)에 순차적으로 공급한다. 여기서, 상기 로우 제어 신호들(RCS1, RCS2) 각각은 스타트 신호 및 복수의 클럭 신호 등을 포함하여 이루어질 수 있다. 일 예에 따른 로우(row) 구동부(220)는 스캔 라인 구동부(222) 및

센싱 라인 구동부(224)를 포함하여 구성된다.

[0088] 상기 스캔 라인 구동부(222)는 상기 제 1 내지 제 m 스캔 제어 라인(SL1 내지 SL m) 각각의 일측 및/또는 타측 각각 연결된다. 이러한 상기 스캔 라인 구동부(222)는 상기 제 1 로우 제어 신호(RCS1)에 기초하여 순차적으로 쉬프트되는 제 1 스캔 신호를 생성하고, 상기 하이 전압과 로우 전압을 이용하여 상기 제 1 스캔 신호를 제 1 스캔 펄스(SP1)로 레벨 쉬프팅시켜 상기 제 1 내지 제 m 스캔 제어 라인(SL1 내지 SL m)에 순차적으로 공급한다.

[0089] 상기 센싱 라인 구동부(224)는 상기 제 1 내지 제 m 센싱 제어 라인(SSL1 내지 SSL m) 각각의 일측 및/또는 타측 각각 연결된다. 이러한 상기 센싱 라인 구동부(224)는 상기 제 2 로우 제어 신호(RCS2)에 기초하여 순차적으로 쉬프트되는 제 2 스캔 신호를 생성하고, 상기 하이 전압과 로우 전압을 이용하여 상기 제 2 스캔 신호를 상기 제 2 스캔 펄스(SP2)로 레벨 쉬프팅시켜 상기 제 1 내지 제 m 스캔 제어 라인(SL1 내지 SL m)에 순차적으로 공급한다.

[0090] 상기 컬럼(column) 구동부(230)는 제 1 내지 제 n 데이터 라인(DL1 내지 DL n)에 연결되어 타이밍 제어부(210)의 모드 제어에 따라 표시 모드와 센싱 모드로 동작한다.

[0091] 상기 표시 모드시, 상기 컬럼(column) 구동부(230)는 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 화소별 보정 테이터(DATA)와 데이터 제어 신호(DCS)에 기초하여 수평 라인 단위로 데이터 전압(Vdata)을 해당 데이터 라인(DL1 내지 DL n)에 공급함과 동시에 레퍼런스 전압(Vref)을 해당 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n)에 공급한다. 상기 센싱 모드시, 상기 컬럼(column) 구동부(230)는 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)와 데이터 제어 신호(DCS)에 기초하여 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압과 이동도를 센싱하여 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 V_{Vth} 과 이동도 V_a 를 상기 타이밍 제어부(210)에 제공한다. 이를 위해, 상기 컬럼(column) 구동부(150)는, 도 7에 도시된 바와 같이, 데이터 구동부(232), 스위칭부(234), 및 센싱부(236)를 포함하여 구성된다.

[0092] 상기 데이터 구동부(232)는 상기 표시 모드에 따라 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 데이터 제어 신호(DCS)에 응답하여, 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 화소별 보정 데이터(DATA)를 데이터 전압(Vdata)으로 변환하여 제 1 내지 제 n 데이터 라인(DL1 내지 DL n)에 각각 공급한다. 그리고, 상기 데이터 구동부(232)는 상기 센싱 모드에 따라 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 데이터 제어 신호(DCS)에 응답하여, 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)를 센싱용 바이어스 전압(Vdata_Sen)으로 변환하여 제 1 내지 제 n 데이터 라인(DL1 내지 DL n)에 각각 공급한다.

[0093] 상기 스위칭부(234)는 상기 표시 모드에 따라 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 데이터 제어 신호(DCS)에 응답하여, 외부로부터 공급되는 레퍼런스 전압(Vref)을 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n)에 각각 공급한다. 그리고, 상기 스위칭부(234)는 상기 센싱 모드에 따라 상기 타이밍 제어부(210)로부터 공급되는 프리차징 스위치 신호에 응답하여 외부로부터 공급되는 프리차징 전압(Vpre)을 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n)에 각각 공급해 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n) 각각을 프리차징 전압(Vpre)으로 초기화한 후, 샘플링 스위치 신호에 응답하여 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n) 각각을 센싱부(236)에 연결시킨다. 이를 위해, 일 예에 따른 스위칭부(234)는 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n) 각각과 센싱부(236)에 연결되는 제 1 내지 제 n 선택기(234a 내지 234n)를 포함하여 구성될 수 있으며, 상기 선택기(234a 내지 234n)는 멀티플렉서로 이루어질 수 있다.

[0094] 상기 센싱부(236)는 상기 센싱 모드시 상기 스위칭부(234)를 통해 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n)에 연결되어 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n) 각각의 전압을 센싱하고, 센싱된 전압에 대응되는 문턱 전압 V_{Vth} 과 이동도 V_a 를 생성하여 타이밍 제어부(210)에 제공한다. 이를 위해, 상기 센싱부(236)는 상기 스위칭부(234)를 통해 제 1 내지 제 n 레퍼런스 라인(RL1 내지 RL n)에 연결되는 제 1 내지 제 n 아날로그-디지털 변환기(236a 내지 236n)를 포함하여 구성될 수 있다.

[0095] 도 8은 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치에 있어서, 센싱 모드시 구동 과정도이다.

[0096] 도 5 내지 도 8을 참조하여 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치의 센싱 모드를 설명하면 다음과 같다.

[0097] 우선, 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치는 화소(P)에 포함된 구동 트랜지스터(Tdr)를 소스 팔로워 모드로 동작시켜 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압을 센싱한다. 이를 위해, 상기 타이밍 제어부(210)는 화소(P)를 제 1 내지 제 3 기간(t1, t2, t3)으로 구동하기 위한 데이터 제어 신호(DCS), 제 1 및 제 2 로우 제어 신호(RCS1, RCS2)를 생성하여 상기 로우(row) 구동부(220)와 컬럼(column) 구동부(230)에 공급함과 동시에 구동

트랜지스터(Tdr)의 게이트 전극에 공급되는 바이어스 전압인 센싱용 데이터(DATA)를 생성하여 컬럼(column) 구동부(230)에 공급한다.

[0098] 또한, 상기 로우(row) 구동부(220)는 제 1 및 제 2 로우 제어 신호(RCS1, RCS2)에 응답하여 센싱 모드 동안 제 1 및 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw1, Tsw2) 각각을 선형(linear) 구동 모드로 동작시키기 위해 서로 동일한 전압 레벨을 상기 제 1 및 제 2 스캔 펄스(SP1, SP2)를 생성하여 스캔 제어 라인(SL)과 센싱 제어 라인(SSL) 각각에 공급한다.

[0099] 그리고, 상기 컬럼(column) 구동부(230)의 데이터 구동부(232)는 상기 데이터 제어 신호(DCS)에 응답하여 상기 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)를 센싱용 바이어스 전압(Vdata_Sen)으로 변환하여 제 1 내지 제 3 기간(t1, t2, t3) 동안 데이터 라인(DL)에 공급한다. 이와 동시에, 상기 컬럼(column) 구동부(230)의 스위칭부(234)는 프리차징 스위치 신호(S_pre)에 응답하여 상기 제 1 기간(t1) 동안 레퍼런스 라인(RL)에 프리차징 전압(Vpre)을 공급한 후, 상기 제 2 기간(t2) 동안 상기 레퍼런스 라인(RL)을 플로팅(floating)시킨 다음, 샘플링 스위치 신호(S_sam)에 응답하여 상기 제 3 기간(t3) 동안 상기 레퍼런스 라인(RL)을 상기 센싱부(236)에 연결시킨다. 이에 따라, 상기 센싱부(236)는 상기 제 3 기간(t3)에 설정된 단축 센싱 시점(Tsen)에서 상기 레퍼런스 라인(RL)의 전압을 센싱하고, 센싱된 전압을 아날로그-디지털 변환하여 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 값(V_Vth)을 생성해 상기 타이밍 제어부(210)에 제공한다.

[0100] 이와 같은 센싱 모드시 상기 로우(row) 구동부(220)와 상기 컬럼(column) 구동부(230) 각각의 구동에 따른 제 1 내지 제 3 기간(t1, t2, t3) 각각의 화소(P) 동작을 설명하면 다음과 같다.

[0101] 먼저, 상기 제 1 기간(t1)에서는, 하이 전압의 제 1 스캔 펄스(SP1)에 의해 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)가 터-온되어 데이터 라인(DL)에 공급되는 센싱용 바이어스 전압(Vdata)이 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트 전극에 공급되며, 하이 전압의 제 2 스캔 펄스(SP2)에 의해 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw2)가 터-온되어 레퍼런스 라인(RL)에 공급되는 프리차징 전압(Vpre)이 상기 센싱 노드(n2)에 공급된다. 이때, 상기 센싱용 바이어스 전압(Vdata)은 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압을 센싱하기 위해 설정된 타겟 전압의 레벨을 갖는다. 이에 따라, 상기 제 1 기간(t1) 동안, 구동 트랜지스터(Tdr)의 소스 전극인 센싱 노드(n2)와 상기 레퍼런스 라인(RL)은 프리차징 전압(Vpre)으로 초기화된다.

[0102] 그런 다음, 상기 제 2 기간(t2)에서는, 하이 전압의 제 1 스캔 펄스(SP1)에 의해 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)의 터-온 상태가 유지되므로 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트 전압은 센싱용 바이어스 전압(Vdata)으로 고정된다. 이때, 상기 레퍼런스 라인(RL)은 상기 컬럼(column) 구동부(230)의 스위칭부(234)에 의해 플로팅 상태가 된다. 이에 따라, 상기 구동 트랜지스터(Tdr)는 게이트 전극에 공급되는 센싱용 바이어스 전압(Vdata)에 의해 포화(saturation) 구동 모드로 동작하게 되고, 이로 인하여 구동 트랜지스터(Tdr)에 흐르는 전류에 대응되는 전압은 커페시턴스의 영향으로 플로팅 상태의 레퍼런스 라인(RL)에 서서히 충전되게 된다.

[0103] 그런 다음, 상기 제 3 기간(t3)에서는, 제 1 및 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw1, Tsw2) 각각이 터-온 상태로 유지되고, 상기 센싱 노드 상의 전압이 포화되는 전압 포화 구간(Tsat) 이전으로 설정된 단축 센서 시점(Tsat)에 발생되는 샘플링 스위치 신호(S_sam)에 의해 상기 레퍼런스 라인(RL)이 상기 컬럼(column) 구동부(230)의 스위칭부(234)를 통해 상기 센싱부(236)에 연결된다. 이에 따라, 상기 센싱부(236)는 상기 레퍼런스 라인(RL)의 전압(Vsense)을 센싱하고, 센싱된 전압(Vsense)을 아날로그-디지털 변환하여 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 값(V_Vth)을 생성해 타이밍 제어부(210)에 제공한다. 따라서, 상기 타이밍 제어부(210)는 화소별 센싱용 바이어스 전압(Vdata)과 상기 센싱부(236)로부터 제공되는 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 값(V_Vth)에 기초하여 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)을 산출해 메모리부(300)에 저장한다. 이때, 상기 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)은 상기 센싱용 바이어스 전압(Vdata)에서 문턱 전압 값(V_Vth)을 뺀 전압(Vdata-V_Vth)이 될 수 있다.

[0104] 한편, 타이밍 제어부(210)는 상기와 같은 센싱 모드를 통해 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 센싱 값(Vth_sen)을 산출하여 메모리부(300)에 저장한 후, 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 이동도를 센싱하기 위한 센싱 모드를 재수행한다. 이 경우, 타이밍 제어부(210)는 전술한 센싱 모드를 동일하게 수행하되, 상기 각 화소(P)의 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)가 상기 제 1 기간(t1) 동안에만 터-온되고, 센싱용 바이어스 전압(Vdata_sen)이 상기 제 1 기간(t1) 동안에만 공급되도록 상기 로우(row) 구동부(220)와 상기 컬럼(column) 구동부(230) 각각의 구동을 제어한다. 이에 따라, 센싱 모드의 재수행시, 상기 제 2 기간(t2)에서는 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)의 터-오프로 인해 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트-소스 전압이 모두 상승됨에 따라 커페시터(Cst)의 전압에 의해 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트-소스 전압이 유지되어 구동 트랜지스터(Tdr)의 흐르는 전

류에 대응되는 전압, 즉 구동 트랜지스터(Tdr)의 이동도 $\Delta(V_a)$ 에 대응되는 전압이 플로팅된 레퍼런스 라인(RL)에 충전된다. 그리고, 센싱 모드의 재수행시, 상기 컬럼(column) 구동부(230)의 센싱부(236)는 상기 레퍼런스 라인(RL)의 전압(Vsense)을 센싱하고, 센싱된 전압(Vsense)을 아날로그-디지털 변환하여 구동 트랜지스터(Tdr)의 이동도 $\Delta(V_{Vth})$ 를 생성해 타이밍 제어부(210)에 제공한다. 따라서, 상기 타이밍 제어부(210)는 상기 센싱부(236)로부터 제공되는 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 이동도 $\Delta(V_a)$ 을 이동도 센싱 $\Delta(a_{sen})$ 으로 산출해 메모리부(300)에 저장한다.

[0105] 도 9는 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치에 있어서, 표시 모드시 구동 파형도이다.

[0106] 도 5 내지 도 7 및 도 9를 참조하여 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치의 센싱 모드를 설명하면 다음과 같다.

[0107] 우선, 표시 모드에 있어서, 상기 타이밍 제어부(210)는 상기 메모리부(300)에서 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 센싱 $\Delta(V_{th_sen})$ 과 이동도 센싱 $\Delta(a_{sen})$ 과 상기 문턱 전압 예측 함수의 연산(V_{th_sat})을 위한 계수들(A, B, C, D)를 추출하고, 추출된 상기 화소별 문턱 전압 센싱 $\Delta(V_{th_sen})$ 과 이동도 센싱 $\Delta(a_{sen})$ 및 계수들(A, B, C, D)을 이용한 상기 수학식 1의 연산을 통해 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 예측 Δ 을 산출한다. 그리고, 상기 타이밍 제어부(210)는 메모리부(300)에 저장된 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 문턱 전압 예측 값과 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 예측 값 간의 편차에 기초하여 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 변화를 보상하기 위한 화소별 특성 보상값을 산출한 다음, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소(P)의 입력 데이터를 보정하여 화소별 보정 데이터(DATA)를 생성한다. 이와 동시에, 상기 타이밍 제어부(210)는 화소(P)를 어드레싱 기간(DM_t1) 및 발광 기간(DM_t2)으로 구동하기 위한 제 1 및 제 2 로우 제어 신호(RCS1, RCS2)를 생성하여 전술한 로우(row) 구동부(220)에 공급함과 동시에 화소별 보정 데이터(DATA)와 데이터 제어 신호(DCS)를 생성하여 컬럼(column) 구동부(230)에 공급한다.

[0108] 상기 로우(row) 구동부(220)는 상기 제 1 및 제 2 로우 제어 신호(RCS1, RCS2) 각각에 응답하여 상기 어드레싱 기간(DM_t1) 동안 하이 전압의 전압 레벨을 가지며 상기 발광 기간(DM_t2) 동안 로우 전압의 전압 레벨을 가지는 제 1 및 제 2 스캔 펄스(SP1, SP2)를 각각 생성하여 스캔 제어 라인(SL)과 센싱 제어 라인(SSl)에 공급한다.

[0109] 상기 컬럼(column) 구동부(230)의 데이터 구동부(232)는 상기 데이터 제어 신호(DCS)에 응답하여 상기 화소별 보정 데이터(DATA)를 데이터 전압(Vdata)으로 변환하여 상기 어드레싱 기간(DM_t1) 동안 데이터 라인(DL)에 공급한다. 이와 동시에, 상기 컬럼(column) 구동부(230)의 스위칭부(234)는 프리차팅 스위치 신호에 응답하여 상기 어드레싱 기간(DM_t1) 동안 레퍼런스 라인(RL)에 레퍼런스 전압(Vref)을 공급한다.

[0110] 이와 같은 표시 모드시 상기 로우(row) 구동부(220)와 상기 컬럼(column) 구동부(230) 각각의 구동에 따른 어드레싱 기간(DM_t1) 및 발광 기간(DM_t2) 각각의 화소(P) 동작을 설명하면 다음과 같다.

[0111] 먼저, 상기 어드레싱 기간(DM_t1)에서는, 하이 전압의 제 1 스캔 펄스(SP1)에 의해 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)가 턴-온되어 데이터 라인(DL)에 공급되는 데이터 전압(Vdata)이 제 1 노드(n1), 즉 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트 전극에 공급되며, 하이 전압의 제 2 스캔 펄스(SP2)에 의해 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw2)가 턴-온되어 레퍼런스 라인(RL)에 공급되는 레퍼런스 전압(Vref)이 제 2 노드(n2), 즉 구동 트랜지스터(Tdr)의 소스 전극에 공급된다. 이에 따라, 제 1 노드(n1)와 제 2 노드(n2)에 접속된 커페시터(Cst)는 상기 데이터 전압(Vdata)과 상기 레퍼런스 전압(Vref)의 차 전압(Vdata-Vref)으로 충전된다.

[0112] 그런 다음, 상기 발광 기간(DM_t2)에서는, 로우 전압의 제 1 스캔 펄스(SP1)에 의해 제 1 스위칭 트랜지스터(Tsw1)가 턴-오프되고, 로우 전압의 제 2 스캔 펄스(SP2)에 의해 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw2)가 턴-오프됨으로써 구동 트랜지스터(Tdr)가 상기 커페시터(Cst)에 저장된 전압(Vdata-Vref)에 의해 턴-온된다. 따라서, 상기 턴-온된 구동 트랜지스터(Tdr)는 상기 데이터 전압(Vdata)과 상기 레퍼런스 전압(Vref)의 차 전압(Vdata-Vref)에 의해 결정되는 데이터 전류(Ioled)를 발광 소자(OLED)에 공급함으로써 발광 소자(OLED)가 구동 전원 라인(PL)으로부터 제 2 전극(또는 캐소드 전극)으로 흐르는 데이터 전류(Ioled)에 비례하여 발광되도록 한다. 즉, 상기 발광 기간(DM_t2)에서, 제 1 및 제 2 스위칭 트랜지스터(Tsw1, Tsw2)가 턴-오프되면, 구동 트랜지스터(Tdr)에 전류가 흐르고, 이 전류에 비례하여 발광 소자(OLED)가 발광을 시작하면서 제 2 노드(n2)의 전압 상승하게 되며, 커페시터(Cst)에 의해 제 2 노드(n2)의 전압 상승만큼 제 1 노드(n1)의 전압이 상승함으로써 커페시터(Cst)의 전압에 의해 구동 트랜지스터(Tdr)의 게이트-소스 전압(Vgs)이 지속적으로 유지되어 발광 소자(OLED)가 다음 프레임의 어드레싱 기간(DM_t1)까지 발광을 지속하게 된다.

[0113] 도 10은 본 발명과 비교 예 1 및 2에 대한 표시 패널의 휘도 균일도를 설명하기 위한 그래프이다.

- [0114] 도 10에서, 본 발명의 그래프는 단축 센싱 방식과 데이터 보상을 모두 적용한 계조별 휘도 균일도를 나타내고, 비교 예 1은 단축 센싱 방식만을 적용한 계조별 휘도 균일도를 나타내며, 비교 예 2는 포화 센싱 방식을 적용한 계조별 휘도 균일도를 나타낸다.
- [0115] 도 10에서 알 수 있듯이, 본 발명은 단축 센싱 방식의 비교 예 1보다 휘도 균일도가 높아지는 것을 확인할 수 있으며, 포화 센싱 방식의 비교 예 2의 그래프와 유사한 형태를 가지는 것을 확인할 수 있다.
- [0116] 결과적으로, 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치는 화소별 구동 트랜지스터의 센싱 시간이 단축되고, 센싱 시간의 단축으로 인한 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차에 따른 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 편차가 보상됨으로써 표시 패널(100)의 휘도 균일도가 향상될 수 있다.
- [0117] 이하, 도 11을 참조하여 전술한 본 발명의 제 2 예에 따른 패널 구동부를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 구성을 예를 들어 설명하기로 한다.
- [0118] 도 11은 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
- [0119] 도 6, 도 7 및 도 11을 참조하면, 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치는 전술한 바와 같이, 표시 패널(100), 패널 구동부(200), 및 메모리부(300)를 포함하고, 상기 패널 구동부(200)는 타이밍 제어부(210), 로우(row) 구동부(220), 및 컬럼(column) 구동부(230)를 포함하여 구성된다. 이러한 구성에 따른 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치에서, 상기 타이밍 제어부(210)와 메모리부(300)를 제외한 나머지 구성들은 전술한 본 발명의 제 1 예에 따른 유기 발광 표시 장치와 동일하므로 이하의 설명에서는 생략하기로 한다.
- [0120] 우선, 메모리부(300)에는 이전의 센싱 모드에 의해 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값(V_{th_sen})과 이동도 센싱 값(a_{sen}), 및 사전 실험에 의해 설정된 센싱용 기준 데이터 전압별 이동도 계수(a_{co})가 저장되어 있다.
- [0121] 상기 센싱 모드시, 상기 타이밍 제어부(210)는 상기 메모리부(300)에서 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 센싱 값(a_{sen})과 센싱용 기준 데이터 전압(V_{data_ref})별 이동도 계수(a_{co})를 추출한 다음, 추출된 화소별 이동도 센싱 값(a_{sen})과 이동도 계수(a_{co})를 이용한 상기 수학식 2의 연산을 통해 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)를 생성함으로써, 도 4에 도시된 바와 같이, 센싱 시간 단축으로 인한 상기 센싱 모드의 단축 센싱 시점(Tsen)에서 발생되는 화소별 구동 트랜지스터(Tdr)의 이동도 편차(a_{high} , a_{low})를 보상한다.
- [0122] 그런 다음, 상기 타이밍 제어부(210)는 생성된 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)를 컬럼(column) 구동부(230)에 제공함과 동기되도록 상기 로우(row) 구동부(220)와 컬럼(column) 구동부(230) 각각을 센싱 모드로 제어한다.
- [0123] 상기 센싱 모드시, 상기 컬럼(column) 구동부(230)는 화소별 센싱용 화소 데이터(DATA)를 화소별 센싱용 데이터 전압($V_{data}'_{sen}$)을 생성하여 해당 화소(P)에 공급하고, 상기 레퍼런스 라인(RL)을 통해 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값(V_{th_sen})과 이동도 센싱 값(a_{sen}) 각각을 센싱하여 상기 타이밍 제어부(210)에 제공한다.
- [0124] 전술한 표시 모드시, 상기 타이밍 제어부(210)는 센싱 모드의 단축 센싱 시점에서 센싱된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값과 최초의 센싱 모드에 의해 센싱되어 메모리부(300)에 저장된 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 센싱 값 간의 편차에 기초하여 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 변화를 보상하기 위한 화소별 특성 보상값을 산출한 다음, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소(P)의 입력 데이터를 보정하여 화소별 보정 데이터를 생성해 각 화소(P)를 구동한다.
- [0125] 이와 같은, 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치는, 도 8에 도시된 센싱 모드의 구동 파형에 따라 센싱 모드를 수행하여 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값(V_{th_sen})과 이동도 센싱 값(a_{sen})을 생성한다. 이때, 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치는 상기 각 화소(P)의 구동 트랜지스터를 소스 팔로워(source follow) 모드로 동작시키기 위한 바이어스 전압으로서, 상기 수학식 2의 연산에 따라 생성된 화소별 센싱용 데이터 전압($V_{data}'_{sen}$)을 사용한다.
- [0126] 그리고, 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치는, 도 9에 도시된 표시 모드의 구동 파형에 따라 표시 모드를 수행하여 각 화소(P)를 구동한다. 이때, 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치는 메모리부(300)에 저장된 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 센싱 값(V_{th_sen})과 화소별 구동 트랜지스터의 최초 문턱 전압 센싱 값 간의 편차에 기초하여 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 변화를 보상하기 위한 화소별 특성 보

상값을 산출한 다음, 산출된 화소별 특성 보상값에 따라 해당 화소(P)의 입력 데이터를 보정하여 화소별 보정 데이터(DATA)를 생성해 각 화소(P)를 구동한다.

[0127] 도 12는 본 발명과 비교 예에 있어서, 데이터 전압에 대한 구동 트랜지스터에 흐르는 전류를 나타내는 그레프이다.

[0128] 도 12의 (a)는 단축 센싱 방식과 문턱 전압 보상을 적용하여 데이터 전압에 대한 구동 트랜지스터에 흐르는 전류를 측정한 비교 예의 그레프이고, 도 12의 (b)는 단축 센싱 방식과 이동도 보상 계인 값 및 문턱 전압 보상을 적용하여 데이터 전압에 대한 구동 트랜지스터에 흐르는 전류를 측정한 본 발명의 그레프이다.

[0129] 도 12의 (a)에서 알 수 있듯이, 비교 예에서는 저계조 영역(LGA)에서 계조 반전이 발생되는 것을 확인할 수 있다. 즉, 비교 예에서는 단축 센싱 시점에서 발생되는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차(a_{high} , a_{low})에 따라 문턱 전압 센싱 값의 편차가 발생되고, 이러한 문턱 전압 센싱 값의 편차를 기반으로 한 문턱 전압 보상으로 인하여 저계조 영역(LGA)에서 계조 반전이 발생하게 된다.

[0130] 반면에, 도 12의 (a)에서 알 수 있듯이, 본 발명에서는 저계조 영역(LGA)에서 계조 반전이 발생되지 않는 것을 확인할 수 있다. 즉, 본 발명은 단축 센싱 방식과 이동도 보상 계인 값을 기반으로, 단축 센싱 시점에서 발생되는 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차(a_{high} , a_{low})를 보상하기 위한, 화소별 센싱용 데이터 전압을 생성하여 문턱 전압을 센싱하고, 이를 기반으로 문턱 전압 보상을 수행하기 때문에 저계조 영역(LGA)에서 계조 반전이 발생되지 않게 된다.

[0131] 결과적으로, 본 발명의 제 2 예에 따른 유기 발광 표시 장치는 화소별 구동 트랜지스터의 센싱 시간이 단축되고, 센싱 시간의 단축으로 인한 화소별 구동 트랜지스터의 이동도 편차에 따른 화소별 구동 트랜지스터의 문턱 전압 편차가 보상됨으로써 표시 패널(100)의 휘도 균일도가 향상될 수 있다.

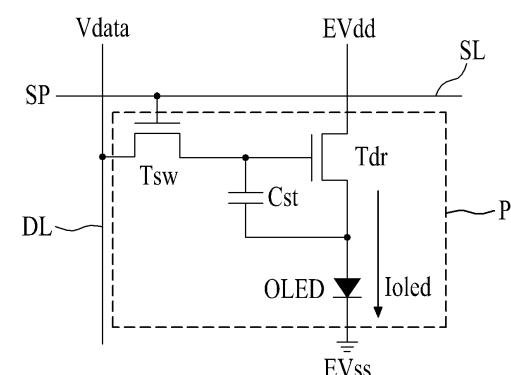
[0132] 이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시 예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사항을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

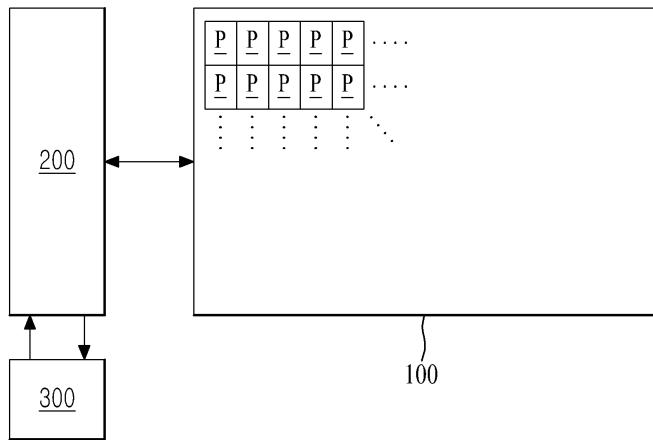
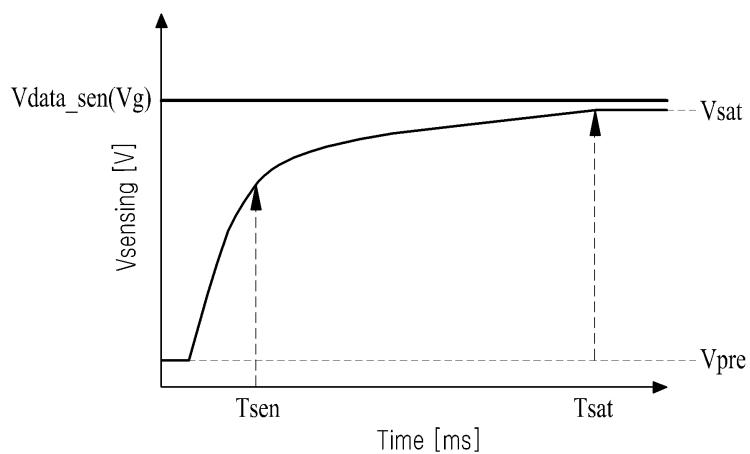
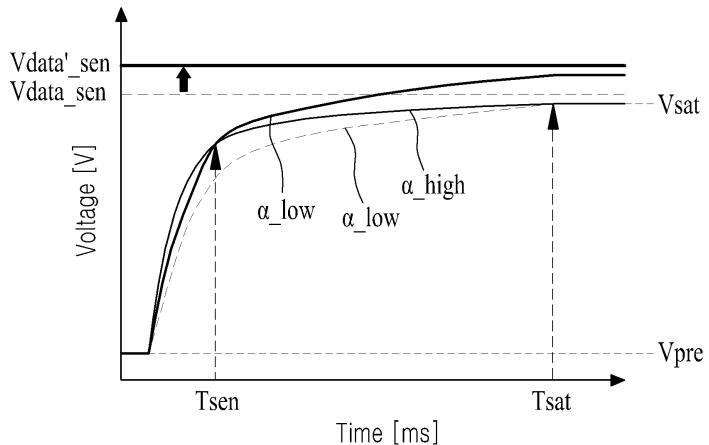
부호의 설명

100: 표시 패널	200: 패널 구동부
210: 타이밍 제어부	220: 로우(row) 구동부
230: 컬럼(column) 구동부	232: 데이터 구동부
234: 스위칭부	236: 센싱부
300: 메모리부	

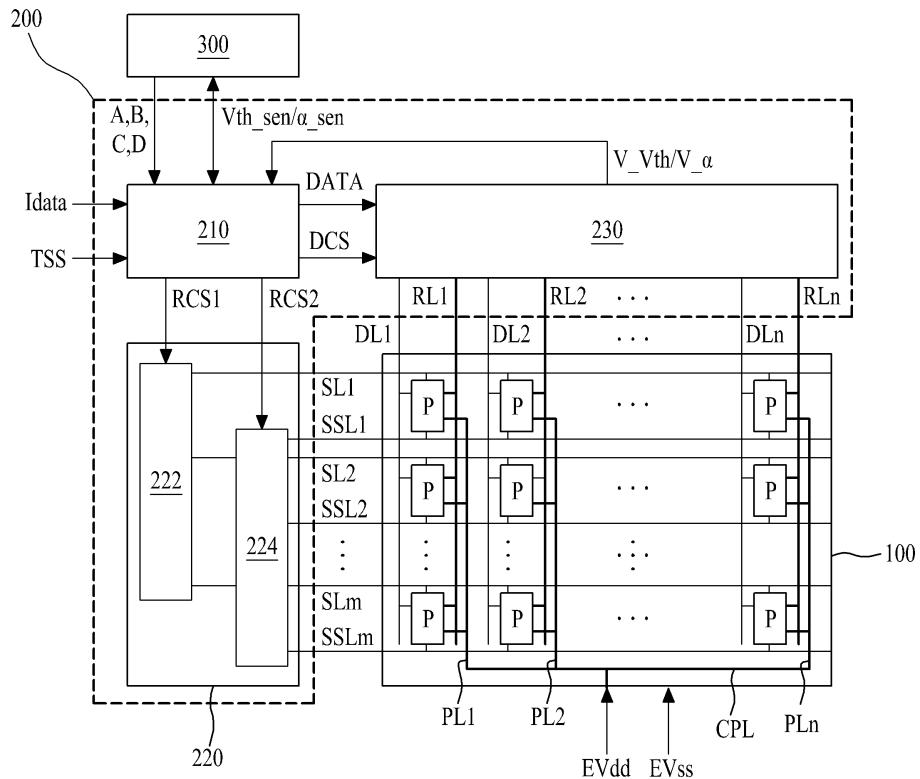
도면

도면1

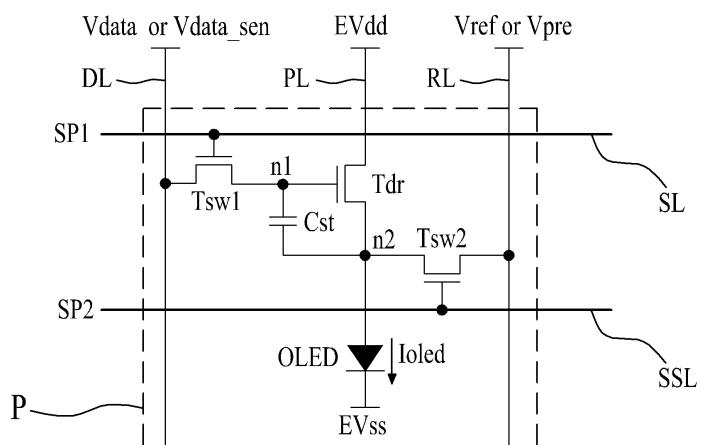


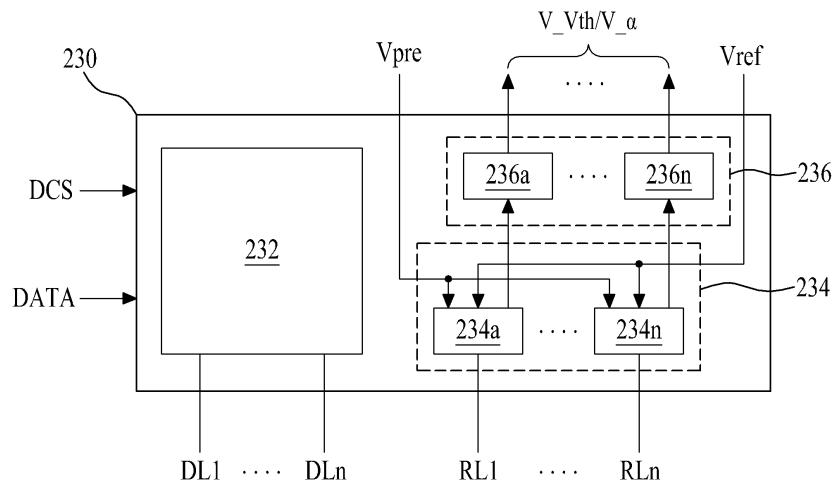
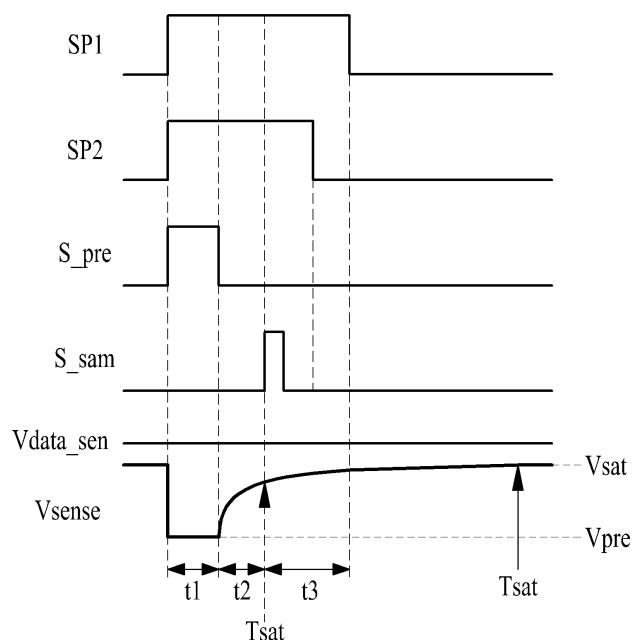
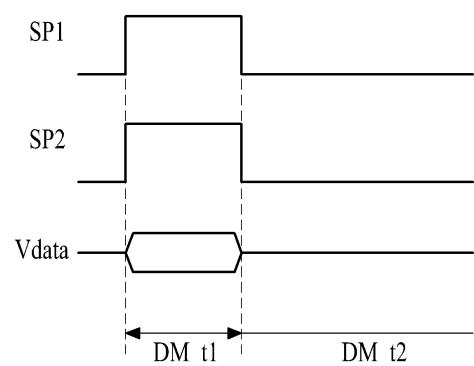
도면2**도면3****도면4**

도면5

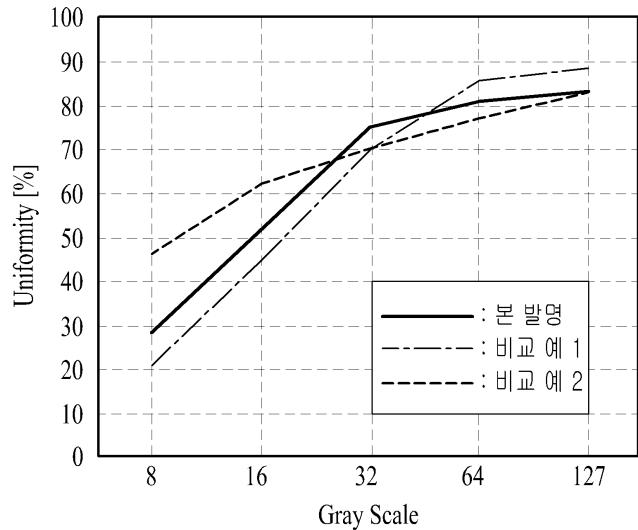


도면6

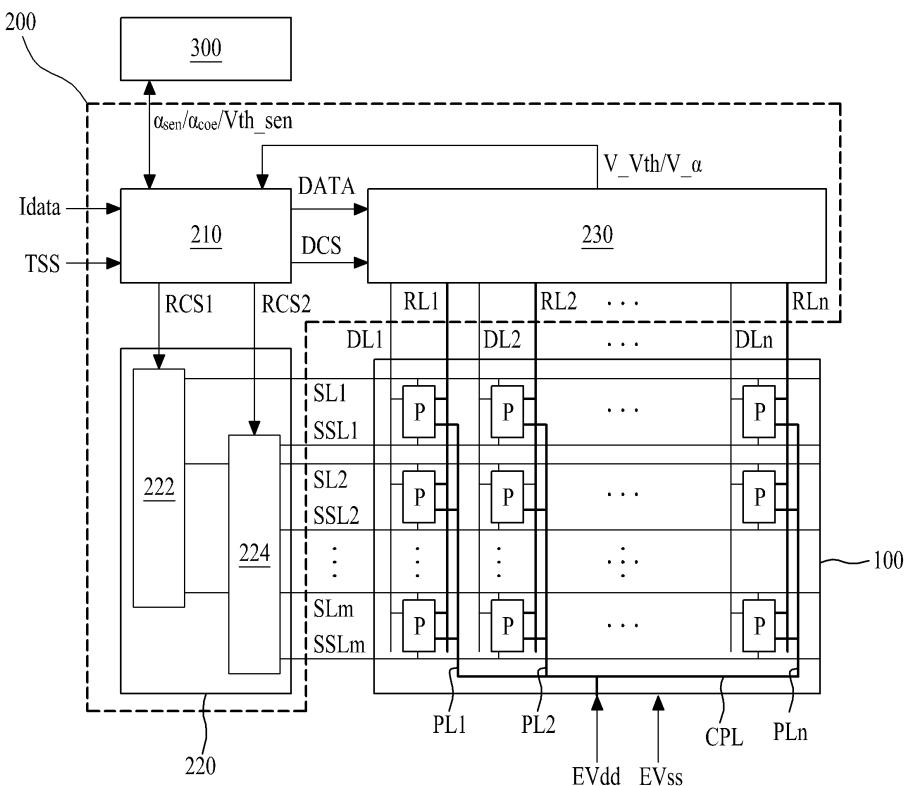


도면7**도면8****도면9**

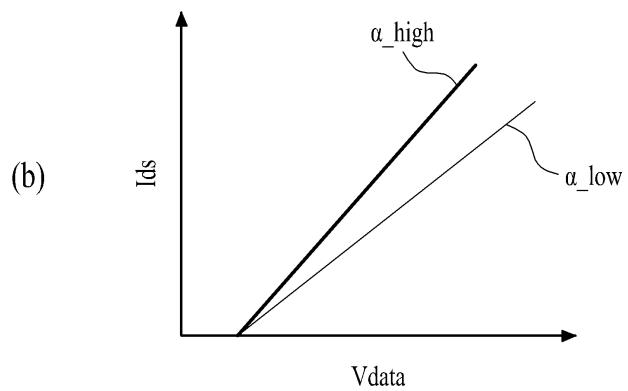
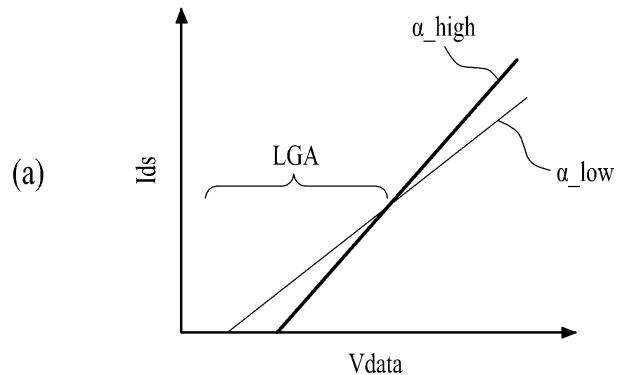
도면10



도면11



도면12



专利名称(译)	有机发光显示器		
公开(公告)号	KR1020160005284A	公开(公告)日	2016-01-14
申请号	KR1020140083952	申请日	2014-07-04
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	JONGHO LEE 이종호 SHINJI TAKASUGI 타카스기신지 MINKYU CHANG 장민규 HYOJIN PARK 박효진		
发明人	이종호 타카스기신지 장민규 박효진		
IPC分类号	H01L27/32		
CPC分类号	G09G3/3291 G09G3/3225		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供一种有机发光显示装置，用于减少驱动晶体管的感测时间。根据本发明的有机发光显示装置包括：显示面板，其包括多个像素，所述多个像素包括驱动晶体管，所述驱动晶体管基于数据电压输出数据电流以允许有机发光元件发光；以及在感测模式或显示模式下操作显示面板的面板驱动单元，通过连接到有机发光元件和驱动晶体管之间的感测节点的参考线来感测每个像素的驱动晶体管的驱动特性值在感测模式时以源跟随模式操作每个像素的驱动晶体管，并且在显示模式时基于每个像素的驱动晶体管的驱动特性值校正每个像素的输入数据驱动每个像素。在感测模式时，面板驱动单元在电压饱和部分之前设置的缩短的感测时间点处感测驱动晶体管的驱动特性值，在该电压饱和部分中，根据在驱动晶体管中流动的电流的感测电压饱和。

